

Сведения об официальном оппоненте:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) официального оппонента:

Турищев Сергей Юрьевич;

ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация:

доктор физико-математических наук, 01.04.10 – физика полупроводников;

ученое звание:

доцент;

полное наименование организации, являющейся основным местом работы официального оппонента на момент представления им отзыва в диссертационный совет, и занимаемая им в этой организации должность (в случае осуществления официальным оппонентом трудовой деятельности) с указанием структурного подразделения
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»,
заведующий кафедрой общей физики;*

список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Kurganskii S. I., Natural surface oxidation consideration in first principles modeling of the X-ray absorption near edge fine structure of silicon / Kurganskii S. I., Dezhina O. A., Manyakin M. D., Parinova E. V., Koyuda D. A., Turishchev S. Y. // Results in Physics. – 2021. – Т. 21. – С. 103778.
2. Ming T., Silicon Suboxides as Driving Force for Efficient Light-Enhanced Hydrogen Generation on Silicon Nanowires / Ming T., Turishchev S., Schleusener A., Parinova E., Koyuda D., Chuvenkova O., Schulz M., Dietzek B., Sivakov V. // Small. – 2021. – Т. 17, № 8. – С. 2007650.
3. Рябцев С.В., Структурные и газочувствительные характеристики тонких полупроводниковых пленок PdO различной толщины при детектировании

- озона / С.В. Рябцев, Д.А.А. Гхариб, С.Ю. Турищев, Л.А. Обвинцева, А.В. Шапошник, Э.П. Домашевская // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, – С. 1034 – 1039.
4. Koyuda D. A., Composition and electronic structure of porous silicon nanoparticles after oxidation under air- or freeze-drying conditions / Koyuda D. A., Titova S. S., Tsurikova U. A., Kakuliia I. S., Parinova E. V., Chuvenkova O. A., Chumakov R. G., Lebedev A. M., Kannykin S. V., Osminkina L. A., Turishchev S. Y. // Materials Letters. – 2022. – Т. 312. – С. 131608.
 5. Parinova E. V., Localization of Dps protein in porous silicon nanowires matrix / Parinova E. V., Antipov S. S., Sivakov V., Belikov E. A., Kakuliia I. S., Trebunskikh S. Y., Turishchev S. Y. // Results in Physics. – 2022. – Т. 35. – С. 105348.
 6. Turishchev S., Spectromicroscopy studies of silicon nanowires array covered by tin oxide layers / S. Turishchev, A. Schleusener, O. Chuvenkova, E. Parinova, P. Liu, M. Manyakin, S. Kurganskii, V. Sivakov // Small. – 2023. – Т. 19. – С. 2206322.
 7. Рябцев С.В., Тонкопленочные оксидные материалы для детектирования озона в режиме термомодуляции / Рябцев С.В., Обвинцева Н.Ю., Гхариб Д.А.А., Аль-Хабиб А.А.К., Шапошник А.В., Турищев С.Ю., Домашевская Э.П. // Неорганические материалы. – 2023. – Т. 59. – С. 508 – 514.
 8. Манякин М.Д., Моделирование из первых принципов и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия рутилоподобных оксидов переходных металлов TiO₂ и MoO₂ / Манякин М.Д., Курганский С.И., Бойков Н.И., Какулия Ю.С., Канныкин С.В., Чувенкова О.А., Чумаков Р.Г., Лебедев А.М., Турищев С.Ю. // Российские нанотехнологии. – 2024. – Т. 19. – С. 354 – 360.
 9. Liu, P., Volcanic eruption in the nanoworld: efficient oxygen exchange at the Si/SnO₂ interface / P. Liu, A. Makarova, K. Freiberg, D. C. Grinter, D. Sharma, P. Ferrer, O. Chuvenkova, T. Deckert-Gaudig, S. Turishchev, S. Lippmann, V. Sivakov // Small. – 2024. – Т. 20. – С. 2404508.
 10. Зур И.А., Зависимость удельного электросопротивления на переменном токе слоев алмазоподобного углерода в наноструктуре In/DLC//Si/In от толщины DLC / И.А. Зур, В.Ю. Леоненко, А.К. Федотов, Е.Е. Шманай, А.А. Харченко, Н.И. Горбачук, Е.А. Ермакова, С.С. Титова, О.А. Чувенкова, С.Ю. Турищев, Ю.А. Федотова, С.А. Мовчан // Физика твердого тела. – 2025. – Т. 67. – С. 246 – 256.